



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100204000
2010 年 12 月 17 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

ASP-MCU TI-DMOS5 サイト製造 一部製品 Wafer供給業者変更のご案内

(第二版 PCN20100204000A 2010 年 3 月 30 日発行, 初版 PCN20100204000 2010 年 2 月 9 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての最終版の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **30** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	TI-DMOS5 サイト製造 ASP-MCU 一部製品 Wafer 供給業者追加 現行 : MEMC 社 Wafer 変更後 : Sumco 社 Wafer、Siltronics 社 Wafer			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2011 年 1 月下旬の出荷より予定しています。 (サンプルは 5 月中旬の出荷より実施しています。)			
品質認定試験	☐ 計画		☒ 終了	
製品表示	☒ 変更無し		☐ 変更あり	
備考	-			

変更内容

内容：弊社 ASP-MCU(マイクロコントローラ) TI-DMOS5(Dallas, 米国)サイト製造 F05 プロセス 一部製品について、現行 MEMC 社 P/P Wafer を使用して製造していますが、MEMC 社製造中止及び TI-DMOS5 F05 プロセス ウェーハ供給業者追加の為に、これに替えて、Sumco 社、Siltronics 社 Wafer を使用した製造を認定しました。今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差)、外観、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

変更内容

Wafer 供給業者

現行

MEMC 社

変更後

Sumco 社

Siltronics 社

理由：MEMC 社製造中止及び TI-DMOS5 F05 プロセス ウェーハ供給業者追加の為

対象製品リスト

対象製品名				
S470AV45AFYSQRB	TMS320F2801PZS-60	TMS320F2808PZS	TMS320F2812PGFA	TMS320F28335ZHHA
SBAV336YSQ	TMS320F28027DAS	TMS320F2808ZGMA	TMS320F2812PGFAG4	TMS320F28335ZJZA
TMP320F28027DAS	TMS320F28027DAT	TMS320F2808ZGMS	TMS320F2812PGFS	TMS320F28335ZJZS
TMP320F28027DAT	TMS320F28027PTT	TMS320F2809GGMA	TMS320F2812ZHHA	TMS470R1VF336APZQ
TMP320F28027PTS	TMS320F2802PZA	TMS320F2809GGMS	TMS320F2812ZHHR	TMS470R1VF478AGJZQ
TMS320F28015PZA	TMS320F2802PZA-60	TMS320F2809PZA	TMS320F2812ZHHS	TMX320F28027PTA
TMS320F28015PZQ	TMS320F2802PZQ	TMS320F2809PZQ	TMS320F28232PGFA	TMX320F28035PAGT
TMS320F28015PZS	TMS320F28044PZA	TMS320F2809PZS	TMS320F28232ZHHA	TMX320F28035PNT
TMS320F28015PZSR	TMS320F2806PZA	TMS320F2809ZGMA	TMS320F28234PGFA	TMX320F28235PGFA
TMS320F28016PZA	TMS320F2806PZQ	TMS320F2810PBKA	TMS320F28234ZHHA	TMX320F28335PGFA
TMS320F28016PZS	TMS320F2806PZS	TMS320F2810PBKQ	TMS320F28234ZJZS	TMX320F28335ZHHA
TMS320F2801PZA	TMS320F2806ZGMS	TMS320F2811PBKA	TMS320F28235PGFA	
TMS320F2801PZA-60	TMS320F2808GGMA	TMS320F2811PBKQ	TMS320F28332PGFA	
TMS320F2801PZQ	TMS320F2808PZA	TMS320F2811PBKS	TMS320F28334PGFA	
TMS320F2801PZS	TMS320F2808PZQ	TMS320F2812GHHA	TMS320F28335PGFA	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信賴性試驗結果				
信賴性試驗期間	開始	2009 年 10 月 15 日	終了	2010 年 12 月 15 日
信賴性試驗 - 試料構成詳細				
Device:	S470PEF363APZQRCV	S470PV242BPZIRQ1	SBAV55BBPGEQR	S4A3482EPZIRSV
Die Size(um):	5761.00 X 5840.00	5162.00 X 5190.00	5401.00 X 5401.00	4006.00 X 4398.00
Wafer Fab:	DMOS5	DMOS5	DMOS5	DMOS5
Wafer technology:	18F05.24L	18F05.24L	18F05.24L	18F05.24L
Assembly Site:	TI Philippines	TI Philippines	TI Philippines	TI Philippines
Pkg/Code/Pins:	LQFP/PZ/100	LQFP/PZ/100	LQFP/PGE/144	LQFP/PZ/100
Die Attach:	Hit EN4085S2K3	Sum CRM-501	Sum CRM-501	Sum CRM-501
Mold Compound:	Hit CEL 9200HF-13	Hit CEL 9200HF-13	Hit MC606-P2P24	Hit CEL 9200HF-13
Leadframe:	NIPDAU	NIPDAU	NIPDAU	NIPDAU
Moisture Level:	JEDEC L-3 / 260C	JEDEC L-3 / 260C	JEDEC L-3 / 260C	JEDEC L-3 / 260C
信賴性試驗結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/Fails	Notes
Write/Erase Cycling	Write/Erase Cycling at 25c / 1000 Cycles		584/0	(1)
HTOL	125C, 1000 Hours		232/0	-
HTSL	150C, 1000 Hours		232/0	-
RTSL	25C, 1000 Hours		120/0	-
ELFR	Max VCC core and I/O, 125C		1200/0	-
ELFR 2	Max VCC core and I/O, 125C, use ELFR		2400/0	-
Device Characterization	-		Approved	(2)
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles		232/0	(3)
ESD-HBM	500V, 1kV, 1.5kV, 2kV		342/0	-
ESD-MM	100V*, 200V*		198/0	-
ESD-CDM	500V, 750V		40/0	-
Latch-up	Per Device Spec		24/0	-
Notes:				
* Information only				
** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC Level-3 / 260C				
(1) Post Initial Elec Test Units for HTOL, HTSL, RTSL				
(2) Supplier and user to mutually agree upon electrical parameters to be measured. Post Initial Elec Test Units				
(3) Perform Bond Pull Strength (BPS) test on 5 parts after stress test. Test 2 bonds per corner and one bond at the middle of the die. Test before & after at 3 temps. Post PC Units				